

注意事項

1. 使用限制: 本機台允許破片(至少 1cm x 1cm 以上)、4 吋、6 吋及 8 吋晶圓蝕刻。
2. 小於八吋之晶片直接放置於 tray 載台上進行蝕刻，禁止使用膠類及矽油塗抹於晶片背面。
3. 晶片需預留 2mm 無光阻之區域，以進行 EPD 監測。
4. 此設備以蝕刻奈米尺寸之結構為主，蝕刻結果需另送 SEM 或 TEM 觀測，才能再行調整。SEM 或 TEM 的觀測需自行委託材料分析組進行觀測。
5. 委託蝕刻材料: 中心將先提供 AlGa_N 及 p-GaN 薄膜蝕刻: AlGa_N film thickness < 30 nm; p Ga_N film thickness < 100 nm。
6. 委託樣品限制: 限制含 Indium (In) 的薄膜材料蝕刻委託，該元素已確認會嚴重影響此設備標準參數蝕刻率與均勻性，故凡樣品含此類元素的薄膜禁用此設備蝕刻，如 InAlGa_N, InAlN, InGa_N, InN、InAlGaAs、InAlAs、InGaAs、InAs、InAlGaP、InAlP、InGaP 及 InP……. 等。
7. 此設備目前僅開放委託代工服務，尚無提供自行操作服務。
8. 若委託者送件的薄膜材料未符合上述規定，可於送件前先與設備負責工程師（許文達 分機 7537）聯絡討論，確認是否可送件。